

	<h2>SI7866ADP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7866ADP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7866ADP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2493 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7866ADP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2493 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 40A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	125nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5415pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7866ADP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7866ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7866ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7866ADP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7866ADP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7866ADP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7866ADP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7866ADP-T1</b> VISHAY VISHAY QFN</p>
 <p><b>SI7866DP-T1-E3</b> VISHAY SI7866DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7866DP-T1</b> VISHAY SI7866DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7866ADP-TA-E3</b> VISHAY VISHAY DFN</p>	 <p><b>SI7864DP-T1-GE3</b> VISHAY SI7864DP-T1-GE3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-T1-E3
 SI7860DP	 SI7860DP-T1	 SI7860DP-T1-E3	 SI7860DP-T1-E3	 SI7860DP-T1-GE3
 SI7860DP-T1-GE3	 SI7860DP-T1-E3	 SI7862ADP	 SI7862ADP-T1-E3	 SI7862ADP-T1-E3
 SI7862ADP-T1-GE3	 SI7862ADP-T1-GE3	 SI7862DP	 SI7862DP-T1	 SI7864ADP
 SI7864ADP-T1-GE3	 SI7864DP-T1-GE3	 SI7866ADP	 SI7866ADP-T1-E3	 SI7866ADP-T1-E3
 SI7866ADP-T1-GE3	 SI7866DP-T1	 SI7866DP-T1-E3	 SI7866DP-T1-GE3	 SI7868ADP
 SI7868ADP-T1-E3	 SI7868ADP-T1-E3	 SI7868ADP-T1-GE3	 SI7868ADP-T1-GE3	 SI7868DP-T1
 SI7868DP-T1-E3	 SI7868DP-T1-GE3	 SI786LG-T1	 SI786LG-T1-E3	 SI7872DP
 SI7872DP-T1-E3	 SI7872DP-T1-E3	 SI7872DP-T1-GE3	 SI7872DP-T1-GE3	 SI7880ADP-T1-E3
 SI7880ADP-T1-E3	 SI7880ADP-T1-GE3	 SI7880ADP-T1-GE3	 SI7880DP-T1-GE3	 SI7882DP-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited